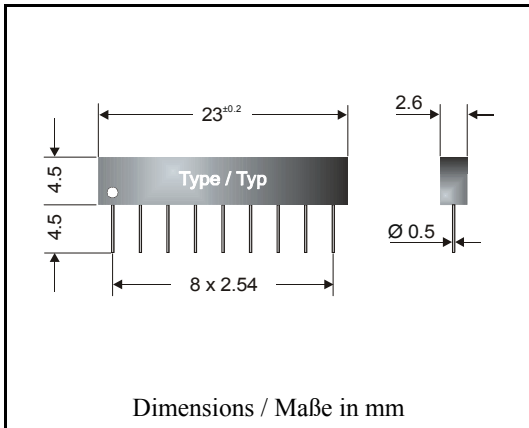
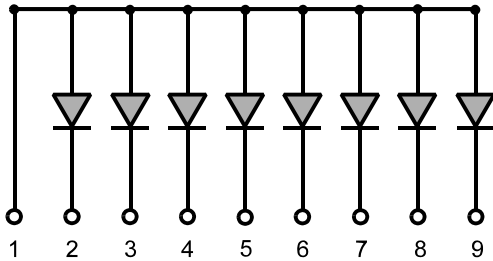


**Fast Switching Rectifier Arrays**

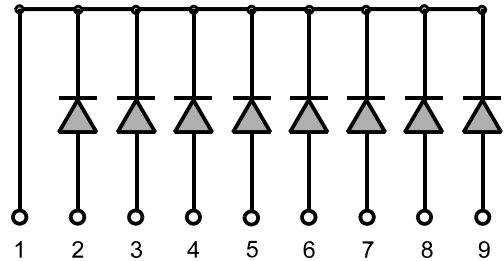
**Schnelle Gleichrichter Sätze**



Nominal power dissipation	1.2 W
Nenn-Verlustleistung	
Repetitive peak reverse voltage	100...400 V
Periodische Spitzensperrspannung	
9 Pin-Plastic case	23 x 2.6 x 4.5 [mm]
9 Pin-Kunststoffgehäuse	
Weight approx. – Gewicht ca.	0.6 g
Standard packaging: bulk	see page 22
Standard Lieferform: lose im Karton	s. Seite 22



"DA 811 A...8110 A": com. anodes / gem. Anoden



"DA 811 K...8110 K": com. cathodes / gem. Kathoden

**Maximum ratings**

**Grenzwerte**

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung $V_{RRM}$ [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung $V_{RSM}$ [V]
DAF 811 A/K	100	120
DAF 814 A/K	400	480

Max. average forward rectified current, R-load, for one diode operation only per diode for simultaneous operation	$T_A = 25^\circ C$	$I_{FAV}$	600 mA <sup>1)</sup>
		$I_{FAV}$	150 mA <sup>1)</sup>
Dauergrenzstrom in Einwegschtung mit R-Last, für eine einzelne Diode pro Diode bei gleichzeitigem Betrieb	$T_U = 25^\circ C$	$I_{FAV}$	600 mA <sup>1)</sup>
		$I_{FAV}$	150 mA <sup>1)</sup>
Peak forward surge current, 50 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwelle	$T_A = 25^\circ C$	$I_{FSM}$	30 A

<sup>1)</sup> Leads kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case  
Anschlußdrähte in 3 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten

Max. power dissipation – Verlustleistung	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$P_{\text{tot}}$	1.2 W <sup>1)</sup>
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur		$T_j$	- 50...+150 °C
Storage temperature – Lagerungstemperatur		$T_S$	- 50...+150 °C

**Characteristics**

**Kennwerte**

Forward voltage Durchlaßspannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 1\text{ A}$	$V_F$	< 1.3 V
Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 100^\circ\text{C}$	$V_R = V_{RRM}$ $V_R = V_{RRM}$	$I_R$ $I_R$	< 10 $\mu\text{A}$ < 90 $\mu\text{A}$
Reverse recovery time Sperrverzug		$I_F = 10\text{ mA through/über}$ $I_R = 10\text{ mA to/auf } I_R = 1\text{ mA}$	$t_{rr}$	< 350 ns
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft			$R_{\text{thA}}$	< 85 K/W <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Leads kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case  
Anschlußdrähte in 3 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten